

DG1H3**30V 1A****特長**

- ・超小型SMD
- ・超薄型=0.8mm
- ・低VF=0.36V

Feature

- Ultra-small SMD
- Ultla-thin PKG=0.8mm
- Low VF=0.36V

用途

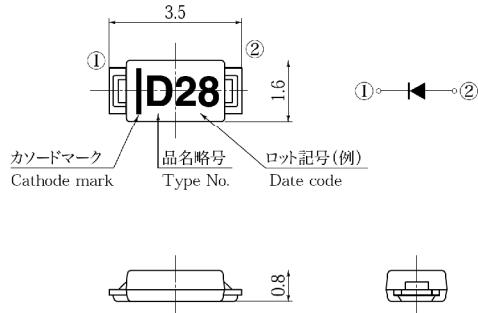
- ・バッテリー逆接防止
- ・DC/DC コンバータ
- Reverse connect protection for DC power source
- DC/DC Converter

Main Use**■外観図 OUTLINE**

Package : G1F

Unit:mm

Weight 0.011g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は「ダイオードカタログ・技術資料編」を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T_l = 25°C)**

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | 品名 Type No. | DG1H3 | 単位 Unit |
|---|------------------|---|--------------------------|---------|---------|
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | | | -55~125 | °C |
| 接合部温度 Operation Junction Temperature | T _j | | | 125 | °C |
| せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage | V _{RM} | | | 30 | V |
| 出力電流 Average Rectified Forward Current | I _o | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load | T _a = 46°C *1 | 0.7 | A |
| | | | T _l = 113°C | 1.0 | |
| せん頭サーボ電流 Peak Surge Forward Current | I _{FSM} | 50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C | | 20 | A |

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T_l = 25°C)

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|----------------------------|----------|------|
| 順電圧 Forward Voltage | V _F | I _F = 0.2A, V _R = V _{RM} , f = 1MHz, V _R = 10V | パルス測定 Pulse measurement | MAX 0.30 | V |
| | | I _F = 0.7A, | パルス測定 Pulse measurement | MAX 0.36 | |
| 逆電流 Reverse Current | I _R | | | MAX 1.0 | mA |
| 接合容量 Junction Capacitance | C _j | | | TYP 37 | pF |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ _{ja} | 接合部・周囲間 Junction to ambient | *1 | MAX 210 | °C/W |
| | | | *2 | MAX 120 | |
| | | | *3 | MAX 70 | |
| | θ _{jl} | 接合部・リード間 Junction to lead | *3 | MAX 20 | |

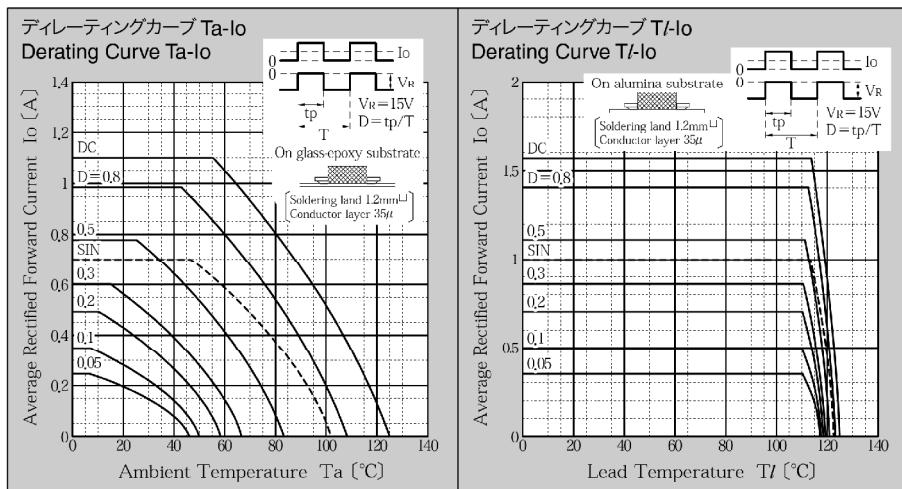
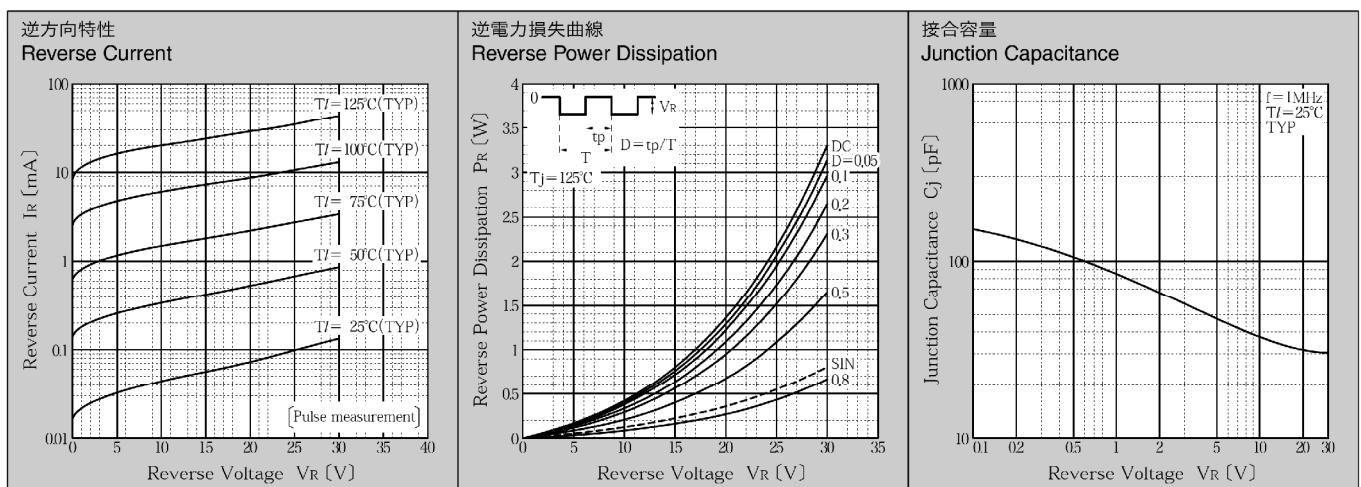
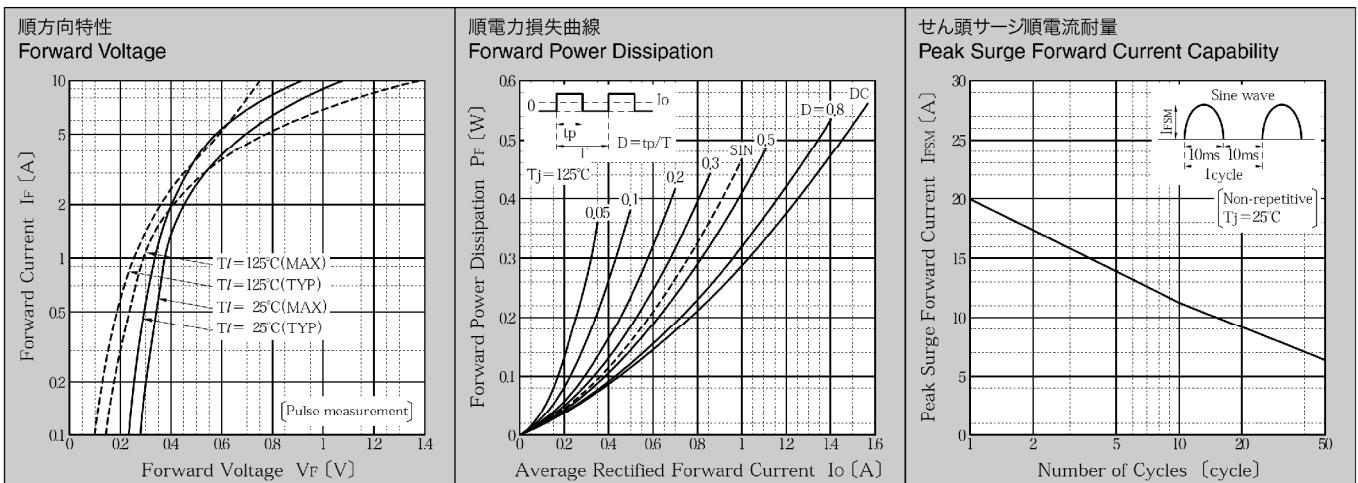
*1 1インチプリント基板 (パターン32.6mm²)
Measured on 1 x 1 inch substrate (pattern area : 32.6mm²)

*2 1インチプリント基板 (パターン160mm²)
Measured on 1 x 1 inch substrate (pattern area : 160mm²)

*3 2インチアルミナ基板 (パターン2,100mm²)
Measured on 2 x 2 inch alumina substrate (pattern area : 2,100mm²)

Small SMD

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



*1インチプリント基板（パターン32.6mm²）
Measured on 1 x 1 inch substrate (pattern area 32.6mm²)

* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は、一般的にバラツキを持っております。
Typical is statistical average of the device's ability.
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.